《基于 OpenFOAM 的磁流体求解器的开发和应用》

的补充材料

李尚卿^{1),2)} 王伟民^{3)†} 李玉同^{1),2),4)‡}

1) (中国科学院物理研究所,北京凝聚态物理国家研究中心,北京 100190)

2) (中国科学院大学物理学院,北京 100049)

3) (中国人民大学物理学系,北京 100872)

4) (松山湖材料实验室,东莞 523808)

† 通讯作者. E-mail: weiminwang1@ruc.edu.cn

‡ 通讯作者. E-mail: ytli@iphy.ac. cn

本文是《基于 OpenFOAM 的磁流体求解器的开发和应用》的补充材料,重 点讨论该文提出的 MHDFoam 求解器的性能。S1 部分为 MHDFoam 求解器的算 法测试,我们利用布里奥-吴(Brio-Wu)激波管问题讨论了 MHDFoam 的时间稳定 性和空间收敛性;S2 部分为 MHDFoam 求解器运用自适应网格细分(adaptive mesh refinement,简记为 AMR)技术消除数值震荡的一个应用实例。

S1 算法测试

布里奥-吴激波管^[1]是一个标准的一维磁流体黎曼问题。无量纲的初始条件如 图 S1 所示, *t* = 0 时刻两部分气体间薄膜破裂,管道中间会形成激波系。图 S2 为 *t* = 0.1 时 Roe-MHD^[1]、FLASH 程序和 MHDFoam 求解器的模拟结果,可以看到 三者运算结果基本一致。



图 S1 布里奥-吴激波管问题的初始条件 Fig. S1. Initialization of the Brio-Wu shock tube problem





(a) y-component of magnetic field profiles; (b) density profiles.

我们对 MHDFoam 求解器的时间稳定性和空间收敛性展开讨论。本文定义密度的数值误差如下:

$$\delta_{N}(\rho) = \frac{\sum_{j=1}^{N} \left| \rho_{j}^{N} - \rho_{j}^{\text{exact}} \right|}{\sum_{j=1}^{N} \left| \rho_{j}^{\text{exact}} \right|}, \qquad (1)$$

其中, ρ_j^{exact} 为坐标 x_j 处的精确解,本文选用 FLASH 八波求解器^[2]的模拟结果,这和文献[3]中的定义不同。我们计算了 Roe-MHD 程序和 MHDFoam 求解器在网格数 N = 800,3200 条件下的密度误差(如图 S3)。三个模拟的 $\Delta t/\Delta x = 0.016$,其中 Δt 为时间步长, $\Delta x = 1/N$ 为网格间距。则它们的一维库朗数 $Co \equiv U_{\text{max}} \Delta t/\Delta x$ 相等,约为 0.02。可以看到相同网格数条件下 MHDFoam 的密度误差(图 S3 蓝色线)小于 Roe-MHD 的(图 S3 红色点划线),这表明 MHDFoam 的时间稳定性较好。根据文献[1],Roe-MHD 采用迎风差分,收敛阶数为 1。根据正文表 1,MHDFoam 的收敛阶数在 1-2 之间,所以密度误差的增长没有 Roe-MHD 的大。增大网格数量会降低误差(图 S3 橙色线),且能抑制误差的波动,这表明 MHDFoam 的空间收敛性较好。



图 S3 布里奥-吴问题的密度误差和时间的依赖关系

Fig. S3. Dependence of density errors on time for the Brio-Wu problem

S2 实例测试

由于截断误差的存在,模拟中激波附近会有数值耗散、色散和震荡^[4]。优化 算法可以部分消除这些非物理现象。本节给出了 MHDFoam 求解器兼容自适应网 格算法的例子,该方法可以消除激波后缘的磁场数值振荡。

我们开展了膨胀磁流体横越磁场的二维数值模拟。初始网格和边界条件如图 S4 所示。以半圆圆心为原点建立坐标系,横向为*x*轴,纵向为*z*轴,则解域范围 为 $\{-0.15 \text{ mm} \le x \le 0.15 \text{ mm}, 0 \le z \le 0.2 \text{ mm}, \sqrt{x^2 + z^2} \ge 0.05 \text{ mm}\}$,网格尺寸约为 1 µm。材料为铜的可压缩理想磁流体从 inlet 半圆边界注入,密度为 3.8×10^{-4} g/cm³, 温度为 10^4 K,速度为 120 km/s。背景密度为 2.5×10^{-7} g/cm³,温度为 300K。磁化 背景中有初始横向磁场 B_{x0} = 10 T,注入磁流体非磁化,inlet 边界上磁场为 0。



Fig. S4. Initialization of mesh and boundary conditions

图 S5(a)为无磁场条件下 *t* = 0.8 ns 时磁流体的密度分布。磁流体呈各向同性膨 胀,半径扩大了 Δ*R* = *Ut* = 120 km/s×0.8 ns ≈ 0.1 mm。当背景横向磁场存在时, 磁流体膨胀呈各向异性(如图 S5(b))。磁流体在 *x* 方向的膨胀距离和无磁场条件下 的大致相同,在 *z* 方向的运动受到抑制,高度较无磁场条件下的低。这是因为磁 流体在横向磁场中膨胀时会推动磁力线,使之弯曲(如图 S6(b)中白线所示)。这种 弯曲的磁力线会产生指向曲率中心的洛伦兹力,使膨胀的等离子体在该方向减速。 当采用静网格时,MHDFoam 求解的磁场会在激波后缘有数值震荡(如图 S6(a)), 这在其它程序的模拟结果中也会出现。出现数值震荡的原因是 MHDFoam 磁场解 耦算法引起的截断误差,而根据 S1 节,增加网格密度可以有效减少误差。我们 采用自适应网格技术来消除数值磁场震荡(如图 S6(b)),自适应网格的策略是对

3

10⁻⁴ ≤ β⁻¹ ≤ 5.0 区域进行 2 阶网格细分(如图 S7)。



图 S5 t = 0.8 ns 时密度廓线 (a)无磁场; (b) $B_{x0} = 10$ T Fig. S5. Density contours at t = 0.8 ns at (a) $B_{x0} = 0$ T; (b) $B_{x0} = 10$ T



图 S6 t = 0.8 ns 时 MHDFoam 求解的磁场,采用 (a)静网格; (b)自适应网格 Fig. S6. Magnetic fields calculated by MHDFoam solver at t = 0.8 ns using

(a) static mesh; (b) adaptive mesh



图 S7 *t* = 0.8 ns 时的自适应网格. Fig. S7. Adaptive mesh at *t* = 0.8 ns

参考文献

[1] Brio M, Wu C C 1988 J. Comput. Phys. 75 400

[2] Powell K G, Roe P L, Linde T J, Gombosi T I, De Zeeuw D L 1999 J. Comput.

Phys. 154 284

- [3] Chelem Mayigué C, Groll R 2016 Arch. Appl. Mech. 87 667
- [4] 张德良 2010 计算流体力学教程(北京:高等教育出版社) 第94页, 第255页